ピレン-安定ラジカル系の光励起状態

(阪市大院理) 〇山達也, 秀熊隆史, 手木芳男

【序】我々は以前に行った研究で、πトポロジーを適切に 考慮してアントラセンと安定ラジカルを π 共役でつない だ分子1がアントラセン部位を光励起することでラジカル 部位のスピン軌道相互作用による零磁場スピン副準位への 選択的増強系間交差が起こり、光励起四重項状態を形成す ることを確認している[1]。また、光励起高スピン状態をと る分子を用いた分子素子の基礎研究の一端として、分子1 を発光層に用いた分子素子を作成し、その EL 発光スペク トルを検出している。また、縮合多環芳香族部位をアント ラセン誘導体系からピレンにかえたピレン-フェルダジル ラジカルからなる分子2が、ピレン部位の励起三重項と側 鎖についている安定フェルダジルラジカル部位との間でス ピン整列が達成され、分子1に匹敵するような比較的強い 信号強度で光励起四重項に由来する時間分解 ESR スペクト ルを与えることを確認している[2]。今回、より良い発光 特性を示す有機高スピンπラジカルを探索する目的でピレ ン-イミノニトロキシドラジカル(分子3)の分子特性と スピン整列について報告をする。また、分子3を発光層に 用いた有機 EL 素子を作成し、その電界発光特性を明らか にする。



【実験】1-ピレンカルボキシアルデヒドを出発物に分子3

を合成した。磁化率測定によりラジカルの純度を、X線構造解析により結晶構造を明らかにした。そして、可視紫外吸収スペクトル測定、基底状態の ESR 測定、時間分解 ESR 測定を行い、基底状態及び光励起状態の電子状態を明らかにした。時間分解 ESR では励起光源としてナノ秒 YAG パルスレーザーでポンプするブロードバンド OPO システムを使用した。また、スピンコーティングと真空蒸着によって分子3を発光層に用いた有機 EL 素子を作成し、EL 発光の検出を試みた。

【結果と考察】図2に分子3の磁化率の温度変化により得られた結果を示す。 これより、ラジカルの純度は約97%と非常に高い値であることが解った。また、





図3 分子**3**のX線構造解析

分子間にはほとんど相互作用がないことも解る。このことから、この系では二 量化などによる発光の消光が起こりにくいことが予測され、高スピンπラジカ ル系を用いた有機 EL の有力候補の可能性が高い。図3にはX線構造解析の結 果求まった分子構造を示す。分子3の結晶は単斜晶系をとっていることが解っ

た。また、ピレン部位とラジカル部位がねじれ て結合した構造をとることから二量体を形成し づらく、先程の磁化率の予測と一致する。図4 に可視紫外吸収スペクトルの測定結果を示す。 250 nm から 400 nm に見られるスペクトルはピ レン骨格部位、450 nm から 550 nm に見られる ブロードなスペクトルはイミノニトロキシドラ ジカル部位に対応する吸収である。ラジカル部 位の n π 遷移に対応する 500 nm で励起後、0.58 μ 秒後の時間分解 ESR スペクトルを図5に示す。 スペクトルの中央に $Ms = -1/2 \Leftrightarrow 1/2$ の遷移が



出現していることから、分子3は光励起四重項状態をとると考えられる。また、 分子3を発光層に用いた有機EL素子を作成し、不安定ながらも青色の発光を確認した。今後、CV測定結果と分子軌道計算結果から分子3のHOMO-LUMO



準位を決定し、より適したキャリア輸 送層を選ぶことにより安定した EL 発 光を検出する予定である。

- Y. Teki, S. Miyamoto, K. Iimura, M. Nakatsuji, and Y. Miura, *J. Am. Chem.* Soc., **122**, 984 (2000).
- [2] Y. Teki, M. Kimura, S.Narimatsu,
 K.Ohara, and K.Mukai, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **77**, 95-99 (2004)